



КТ668А, КТ668Б, КТ668В

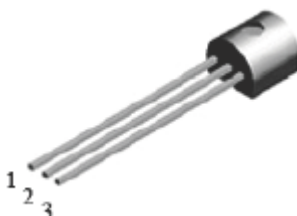
Кремниевые усилительные р-п-р транзисторы средней мощности

Типовое значение граничной частоты передачи тока $f_{ГР} = 200$ МГц
Максимальная рассеиваемая мощность коллектора $P_{Кmax} = 500$ мВт
Максимальное постоянное напряжение коллектор-база $U_{КБmax} = 50$ В

Тип изделия	НомерТУ	Тип корпуса	Диапазон рабочих температур
КТ668А, КТ668Б, КТ668В	аА0.336.717 ТУ	КТ-26 (ТО-92)	-60°C до +125°C

Кремниевые планарно - эпитаксиальные усилительные р-п-р транзисторы с нормированным коэффициентом шума в пластмассовом корпусе с гибкими выводами типа КТ668 могут применяться в усилительных, генераторных и переключающих устройствах аппаратуры широкого применения. Маркировка транзисторов соответствует техническим условиям аА0.336.717 ТУ.

Схема расположения выводов КТ668А, КТ668Б, КТ668В



- 1 - Эмиттер
- 2 - База
- 3 - Коллектор

КТ-26

Основные электрические параметры при $T = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	КТ668 по группам		
		А	Б	В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 2$ мА не менее не более	$h_{21Э}$	75 140	125 250	220 475
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 10$ мА, $f = 100$ МГц не менее	$ h_{21Э} $	2		
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В при $I_К = 10$ мА, $I_Б = 0,5$ мА не более	$U_{КЭнас}$	0,3		
Коэффициент шума на $f = 1$ кГц, дБ при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_К = 0,2$ мА, $R_Г = 2$ кОм не более	$K_{ш}$	10		
Обратный ток коллектора, нА при $U_{КБ} = 30$ В не более	$I_{КБО}$	15		
Обратный ток эмиттера, нА при $U_{ЭБ} = 5$ В не более	$I_{ЭБО}$	100		
Емкость коллекторного перехода, пФ при $U_{КБ} = 10$ В, $f = 10$ МГц не более	$C_К$	7		



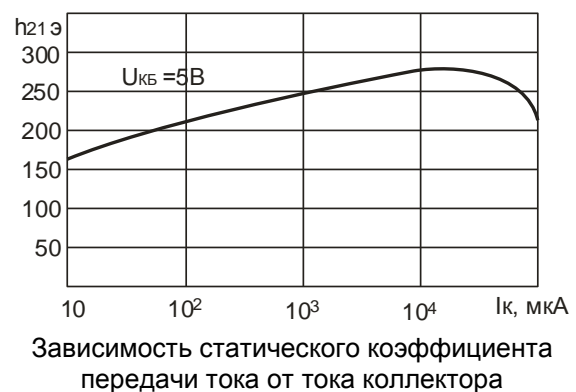
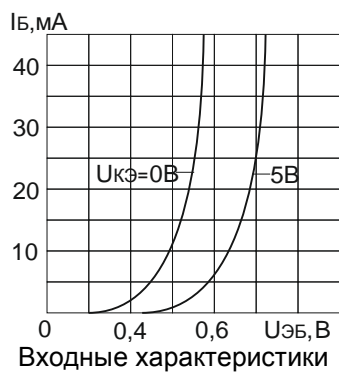
Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	Примечания
		КТ668А, КТ668Б, КТ668В	
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБ\max}$	50	1
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $I_K=2\text{ мА}$, $R_{БЭ}=\infty$, В	$U_{КЭ0\max}$	45	1
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ\max}$	5	1
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{К\max}$	100	1, 2
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, мА	$I_{КИ\max}$	200	1, 2
Максимально допустимый постоянный ток базы, мА	$I_{Б\max}$	50	1, 2
Максимально допустимая рассеиваемая мощность коллектора, мВт до $T = +25\text{ }^\circ\text{C}$	$P_{К\max}$	500	3
Максимально допустимая температура перехода, $^\circ\text{C}$	T_p	150	
Общее тепловое сопротивление, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Т-п-с}$	250	

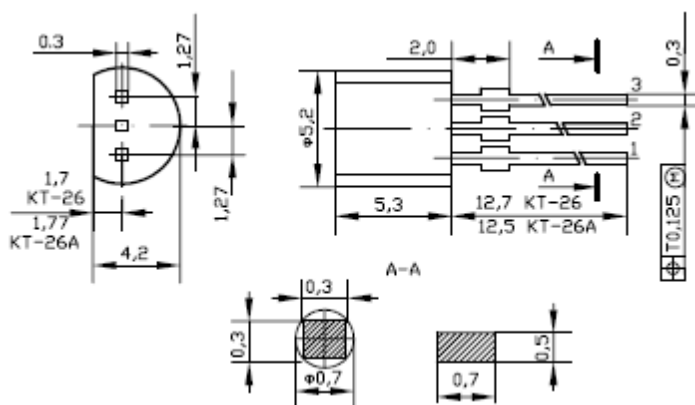
Примечания:

- 1) При $T = -60\text{ }^\circ\text{C}$ до $+125\text{ }^\circ\text{C}$
- 2) При условии неперевышения $P_{К\max}$.
- 3) При температуре окружающей среды от минус $60\text{ }^\circ\text{C}$ до $+25\text{ }^\circ\text{C}$. При температуре выше $+25\text{ }^\circ\text{C}$ $P_{К\max}$ рассчитывается по формуле: $P_{К\max} = (150 - T_{окр.ср}) / R_{Т-п-с}$, Вт.

Основные типовые зависимости параметров транзисторов



Габаритные чертежи используемых корпусов



- 1 - Коллектор
 - 2 - База
 - 3 - Эмиттер
- Допускается отсутствие выступов на выводах. Позиционный допуск на расстоянии 2,0 мм max.

Корпус КТ-26